



## ニュースリリース

2007年10月5日

\*米国時間 2007年10月4日にエルピーダメモリとラムバスより発表されたニュースリリースの抄訳です

### エルピーダがラムバスの XDR メモリアーキテクチャを採用した 世界最高速の DRAM を発表

#### 4.8GHz 動作 XDR DRAM は業界標準の DDR2 DRAM と比較して 6 倍の性能を達成

DRAM のリーディングカンパニーであるエルピーダメモリ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長兼 CEO:坂本幸雄 以下、エルピーダ)と半導体チップ間的高速インタフェースを開発する技術ライセンス会社、ラムバス社(米国カリフォルニア州、NASDAQ:RMBS 以下、ラムバス)は本日、ラムバスの XDR メモリアーキテクチャを採用した業界最速の DRAM である 512Mb 4.8GHz 動作 XDR™ DRAM を発表しました。XDR DRAM ファミリーで最新のデバイスであるこの XDR DRAM は、1 デバイスで業界最高の 9.6 ギガバイト/秒のデータ転送レートを実現し、デジタルテレビ、ゲーム機、PC、サーバ、ワークステーションなどの高性能・量産向けアプリケーションに最適なメモリです。

エルピーダのデジタルコンシューマ事業部担当執行役員である木下嘉隆は、次のようにコメントしております。「フルハイビジョン対応のデジタルテレビのような高解像度のイメージデータが一般に普及するにつれ、次世代のシステムでは高バンド幅メモリの必要性が急速に高まっています。ラムバスとともに XDR DRAM に取り組むことにより、コストパフォーマンスに非常に優れたメモリソリューションをコンシューマエレクトロニクスおよびコンピューティング市場に提供することが出来ます。」

エルピーダの 512Mb 4.8GHz XDR DRAM(製品名:EDX5116ADSE-5E-E)は、8バンク構成(x16, x8, x4プログラマブル)で、9.6ギガバイト/秒のデータ転送レートを実現します。このデータ転送レートは、業界標準のDDR2-800メモリデバイスのピークバンド幅と比較して約6倍です。4.8GHz XDR DRAMは、エルピーダの70nmプロセス技術で製造され、104ボールFBGAパッケージを採用しています。超高速動作と高いデータ転送レートの両方を可能にするために、XDR DRAMデバイスにはラムバスの特許をベースに開発した以下のキーイノベーションが含まれています。超低振幅の差動ラムバス信号レベル(DRSL);一般的な600MHzクロックでも4.8GHz動作を可能にするためにクロック1サイクルあたり8ビット転送するオクタルデータレート技術(ODR);クロック位相にあわせてデータタイミングをチップ上で調整するFlexPhase™回路技術です。また、512Mb XDR DRAMデバイスは、アダプティブ インピーダンス マッチング、ダイナミック リクエスト スケジュール、オーバーヘッドなしのリフレッシュなどの機能を備えています。

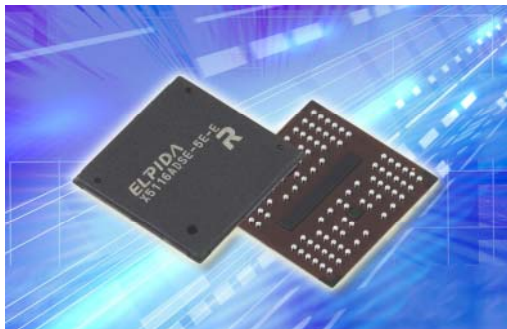
ラムバスのセールス/ライセンシング/マーケティング担当 上級副社長 シャロン・ホルトは、「エルピーダの4.8GHz XDR DRAMは、3Dグラフィックス、高解像度イメージプロセッシング、最先端マルチメディアなど、高いバンド幅が必要とされるコンシューマエレクトロニクス アプリケーションに最適なメモリです。エルピーダは、XDR DRAMのリーディング サプライヤとしての実績を確立しており、今回、エルピーダとともにXDR DRAMのロードマップを発展させ、業界最速のDRAMを実現したことを大変喜ばしく思っています。」と述べています。

XDR DRAM は XDR メモリアーキテクチャの不可欠な要素で、XDR メモリコントローラ(XMC)、XIO コントローラ・インタフェイスセル、XCG(XDR クロックジェネレータ)とシームレスに動作し、最小限のコンポーネント数ながら、非常に高いメモリ性能を発揮します。x16 モードの XDR DRAM デバイス 1 個で 9.6 ギガバイト/秒のデータ転送レートを実現します。一方で、x16 モードの DDR2-800 の場合、XDR DRAM と同等のデータ転送レートを達成するためには 6 個の DDR2 デバイスが必要となります。

ラムバスの XDR メモリソリューションは、ゲーム機、プロジェクションテレビ、サーバなどの製品においてすでに実績があり、チップ開発からシステム統合、低コスト化に至るまで包括的な技術サポートを提供しています。XDR DRAM は、既存の標準的メモリと比較して、遥かに高い性能を提供し続けます。マイクロスレーディングを適用した次世代メモリである XDR2 DRAM を含む XDR メモリ技術の詳細は、[www.rambus.co.jp/xdr](http://www.rambus.co.jp/xdr) をご覧ください。

#### 製品出荷予定

エルピーダの 512Mb 4.8GHz XDR DRAM デバイス(製品名:EDX5116ADSE-5E-E)は、2007 年 12 月よりサンプル出荷を開始いたします。また 2008 年 4 月に量産開始を予定しております。データシートはリクエストに応じてご提供いたします。



#### エルピーダメモリ株式会社について

エルピーダメモリ株式会社(TSE:6665)は、DRAM(ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ)のリーディングカンパニーです。世界トップレベルの技術力により、開発・設計・製造・販売活動を積極的に展開しています。最先端の製造技術を誇る生産拠点、広島エルピーダメモリ株式会社(前工程)と秋田エルピーダメモリ株式会社(後工程)を有し、また、世界のお客さまをサポートする販売・マーケティング拠点は、日本国内に加え、北米、ヨーロッパ、台湾、中国、シンガポールにあります。エルピーダは、大容量、高速、低消費電力、小型パッケージなどの先端製品ラインナップにより、ハイエンドサーバ、携帯電話、デジタル家電など幅広い応用分野にお応えします。エルピーダメモリに関するさらに詳細な情報は、<http://www.elpida.com> でご覧いただけます。

## ラムバス社について

ラムバス社は、半導体チップ間的高速インタフェイスを開発・設計し、技術ライセンス供与を行う世界有数の企業です。1990年に設立以来、ラムバス社は革新的技術と専門知識の提供を通じて、主要チップメーカー、システム機器メーカーがインタフェイス間の性能格差を解消し、市場へ高性能な製品を提供できるように支援しています。ラムバス社のインタフェイス・ソリューションは、現在、コンピュータやコンシューマ機器、ネットワーク機器など、数多くの高性能アプリケーションで採用されています。ラムバス社は、カリフォルニア州ロス・アルトスに本拠をおき、ノースカロライナ州、インド、ドイツ、日本、韓国、台湾にオフィスを有しています。ラムバスに関するさらに詳細な情報は、<http://www.rambus.co.jp>でご覧いただけます。

*Rambus* と *Rambus* ロゴは、米国ラムバス社の登録商標です。 *XDR* と *FlexPhase* はラムバス社の商標です。 その他記載されている製品名、会社名は、ラムバス社もしくは保有各社の登録商標または商標です。

###

## プレスお問い合わせ先:

ラムバス株式会社

大塚 雅美

Tel: 03-4580-6813

US Tel: +1-650-391-5813

[otsuka@rambus.com](mailto:otsuka@rambus.com)

エルピーダメモリ株式会社

コーポレート・コミュニケーション・グループ

樋口・齋藤・鶴巻

Tel: 03-3281-1648

[press@elpida.com](mailto:press@elpida.com)